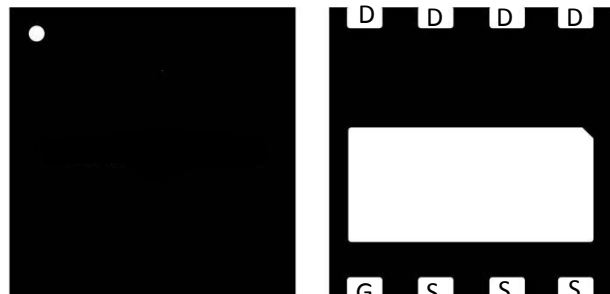


产品摘要 (典型)	
RDS(on) (mΩ)	55
Qrr (nC)	78
VDS (V)	650

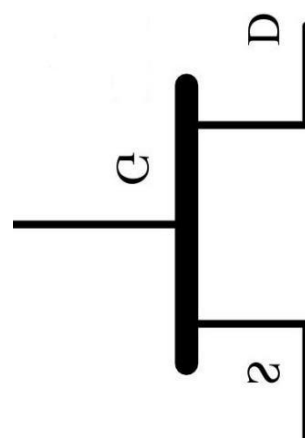


### 产品特点：

- 低 QRR
- 无需续流二极管
- 用于降低 EMI 的高端安静标签™
- 符合 RoHS 标准
- 高频操作

### 产品应用：

- 紧凑型 DC-DC 变换器
- 交流电机驱动
- 电池充电器
- 开关电源



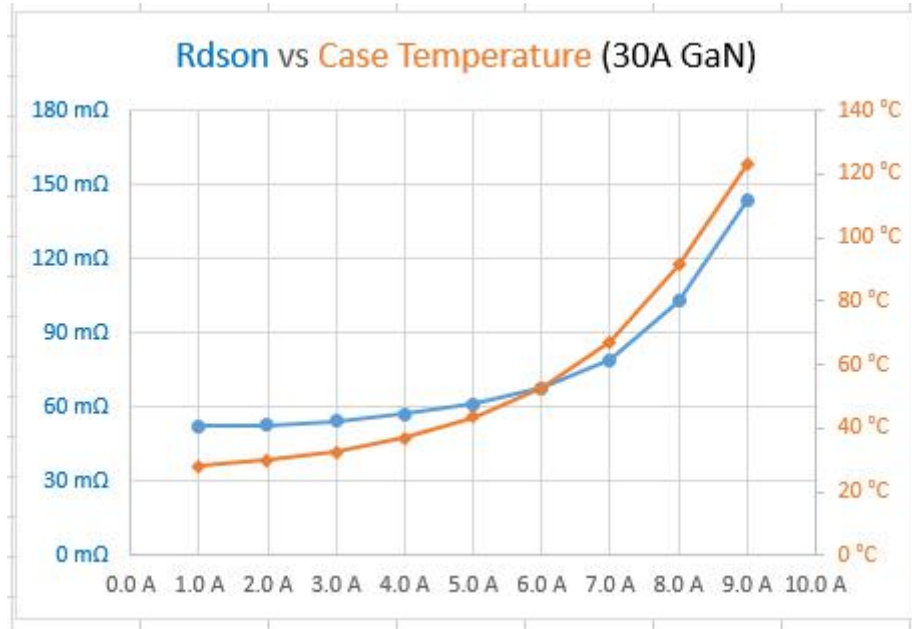
极限参数 (T <sub>C</sub> =25 °C 若无特殊说明)			
符号	参数名称	极限值	单位
ID 25° C	漏极电流 (直流) @T <sub>c</sub> =25 ° C	39	A
ID 125° C	漏极电流 (直流) @T <sub>c</sub> =125 ° C	17.2	A
IDM	漏极脉冲电流 (pulse width:50 us)	78	A
VDSS	漏源击穿电压	650	V
VGSS	栅源电压 (直流)	±6	V
TJ	结温工作温度	-55 to 150	° C
PD 25° C	漏极最大允许耗散功率	165	W
TS	贮存温度	-55 to 150	° C
TCsold	焊接峰值温度 <sup>b</sup>	260	° C

耐热性			
符号	参数名称	典型值	单位
R $\theta$ JC	结壳热阻	0.8	° C /W

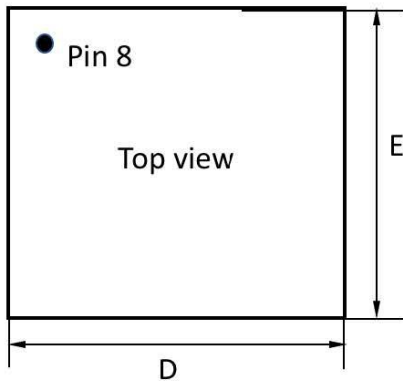
## 电气特性 (TC=25 ° C 若无特殊说明)

序号	参考符号	参数名称	测试条件	典型值	单位
静态参数					
1	Vgs(TH)	Gate Threshold Voltage	Vds=Vgs Id=4.6mA	1.4	V
2	BVdss	Drain-Source breakdown voltage	Vgs=0V Id=25uA	650	V
3	Idss	Zero gate voltage drain current, TC = 25°C	Vgs=0V Vds=650V	1.2	uA
4	Idss	Zero gate voltage drain current, TC = 150°C	Vgs=0V Vds=650V	30	uA
5	Igss	Gate-Source Leakage	Vgs = 6V Vds = 0V	12.7	uA
6	Rdson	static Drain-Source on resistance, TC = 25°C	Vgs=6V Id=7.5A	0.055	Ω
7	Rdson	static Drain-Source on resistance, TC = 150°C	Vgs=6V Id=7.5A	0.106	Ω
8	Vsd	Body diode forward voltage	I <sub>sd</sub> =1A Vgs=0V	1.79	V
动态参数					
1	capacitance	Ciss	Vgs=0V		pf
		Coss	Vds=400V		pf
		Crss	f=1MHz		pf
3	Qg	Gate charge	Vds=400V		nC
	QgS		Id=7.5A		nC
	Qgd		Vgs=6V		nC
开关性能					
1	td(on)	Turn-on delay time	Vds=400V		ns
2	tr	Rise time	Id=2.5A		ns
3	td(off)	Turn-off delay time	Rg=10 Ω		ns
4	tf	Fall time	Vgs=6V		ns

电特性曲线(TC=25°C):



封装形式 (DFN8X8, Unit: mm):



D=8; E=8; e=1.95; b=0.97;  
L=0.57; D2=6.82; E2=3.19

8LEAD DFN (8x8x0.75mm,  
Pitch 1.95mm)

**IMPORTANT:** Please connect  
the bottom thermal pad to  
the source electrode on PCB

